

# FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA ESCUELA DE INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIÓN

CARRERA: INGENIERÍA TELECOMUNICACIONES

**ASIGNATURA:** ELECTRONICA I

**DOCENTE:** ING. PAUL ROMERO

**NIVEL:** 4° SEMESTRE "A"

### **REALIZADO POR GRUPO Nº4:**

Miguel Alonso Cartagena Soto Oscar Diego Regalado Santin Jhony Iván Gualan Gualan Steve Fabian Parra Soria



Riobamba-Ecuador

#### PROYECTO N°2

### Objetivo General

 Generar un proyecto integrador que involucre el diseño y simulación de circuitos electrónicos utilizando dispositivos semiconductores tales como Transistores de Unión Bipolar BJT, Transistores de Efecto de Campo (JFET y MOSFET) y otros componentes activos y pasivos necesarios para la implementación.

### Objetivos Específicos

- Desarrollar un amplificador de audio para micrófono (mínimo 2 etapas) utilizando transistores BJT, componentes e instrumentos disponibles en MULTISIM.
- Diseñar un circuito preamplificador de audio (mínimo 2 etapas) utilizando transistores de efecto de campo (JFET o MOSFET), componentes e instrumentos disponibles en MULTISIM.
- Implementar y caracterizar las compuertas lógicas digitales (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR) de la familia lógica CMOS usando Transistores de Efecto de Campo, componentes e instrumentos disponibles en ORCAD-PSPICE.
- Obtener las gráficas y mediciones de valores de voltaje, corriente y otros parámetros por cada uno de los casos y etapas correspondientes, con ayuda de los instrumentos y opciones de simulación de Multisim o PSpice.

#### Actividades Planteadas.

- Mediante las herramientas de simulación y análisis de circuitos Multisim o PSPICE diseñe los circuitos correspondientes en cada caso.
- Calcule y mida los valores de voltajes, corrientes en los terminales de los transistores de unión bipolar (BJT) y transistores de Efecto de campo utilizados en cada circuito.

- Calcule y mida las ganancias totales, ganancia por etapa en los circuitos amplificadores.
- Para el circuito amplificador de micrófono utilice los compontes Microphone
   y Speaker disponibles en Multisim.
- Diseñe e implemente las compuertas lógicas TTL: NOT, AND, OR, NAND,
   NOR, XOR de dos entradas utilizando transistores MOSFET.
- Comprobar el funcionamiento de las compuertas lógicas (funciones lógicas y tablas de verdad).
- Calcule y obtenga los valores de voltajes, corrientes, por cada uno de los circuitos equivalentes a las compuertas.
- Realice un informe detallado de esta actividad utilizando el formato de trabajos de investigación. En el contenido incluya los esquemas, tablas de verdad o de funcionamiento, parámetros calculados, valores medidos y gráficas de salida por cada uno de los casos.

### Desarrollo de la Practica.

#### Fundamentación Teórica

#### • Transistores JFET

El transistor de unión bipolar (BJT, bipolar junction transistor) está basado en dos tipos de carga: los electrones libres y los huecos; razón por la que se denomina bipolar: el prefijo bi quiere decir "dos". Este tipo de dispositivo es unipolar porque su operación sólo depende de un tipo de carga, electrones libres o huecos. En otras palabras, un FET tiene portadores mayoritarios, pero no portadores minoritarios.

#### • Transistores MOSFET

Un MOSFET es un dispositivo semiconductor utilizado para la conmutación y amplificación de señales. El nombre completo, Transistor de Efecto de Campo de Metal-Óxido-Semiconductor (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, MOSFET) se debe a la constitución del propio transistor, está basado en la estructura MOS.

### • Familia Lógica TTL

Es una familia **lógica** o lo **que es** lo mismo, una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales. En los componentes fabricados con tecnología **TTL** los elementos de entrada y salida del dispositivo son transistores bipolares.

#### Compuertas Lógicas

Las Compuertas Lógicas son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales de voltaje como resultado o una salida de forma booleana, están obtenidos por operaciones lógicas binarias (suma, multiplicación).

#### Desarrollo Amplificador

### Analisis 1 y 2:

$$I_{B} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{B}} = \frac{9V - 0.7V}{100k\Omega} = 83\mu A$$

$$I_{E} = (\beta + 1)I_{B} = (100 + 1)(83\mu A) = 8.38mA$$

$$r_{e} = \frac{25mV}{I_{E}} = \frac{25mV}{2.428mA} = 2.98\Omega$$

$$Z_{i} = R_{B} || \beta r_{e} = \frac{R_{B}\beta r_{e}}{R_{B} + \beta r_{e}} = \frac{(100k\Omega)(100)(2.98\Omega)}{(100k\Omega) + (100)(2.98\Omega)}$$

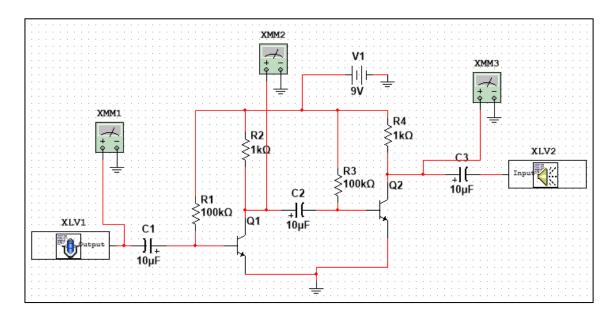
$$= 297.11\Omega$$

$$Z_{0} = R_{C} = 1k\Omega$$

$$A_{v1,2} = -\frac{R_{C}}{r_{e}} = -\frac{1k\Omega}{2.98\Omega} = -335.57$$

$$A_{vT} = A_{v1}A_{v2} = (-335.57)(-343.75) = 112.607k$$

### Simulación



Resultados.

# Compuertas Lógicas

# Compuerta OR:

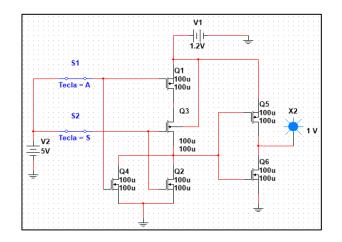
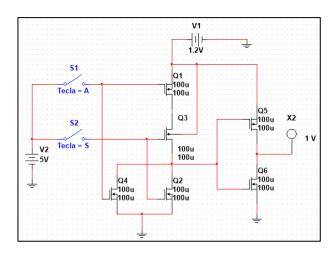
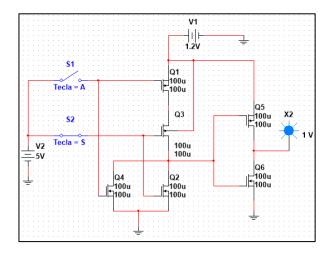
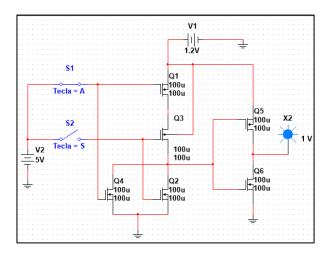


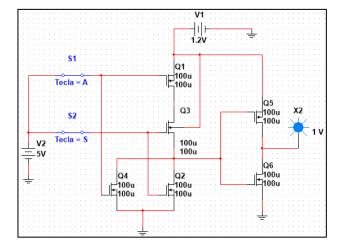
Tabla de verdad			
#	а	b	<i>a</i> + <i>b</i>
1	0	0	0
2	0	1	1
3	1	0	1
4	1	1	1





# Comprobación Nº3





# Compuerta AND

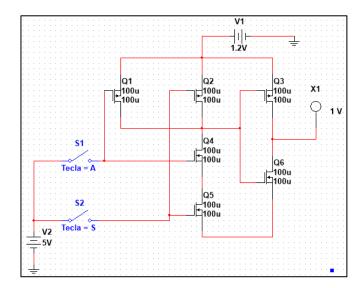
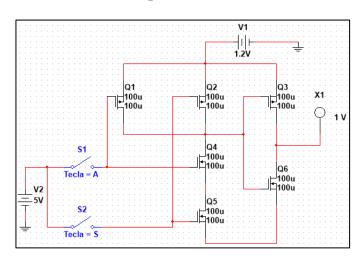
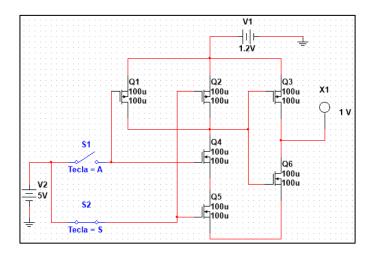
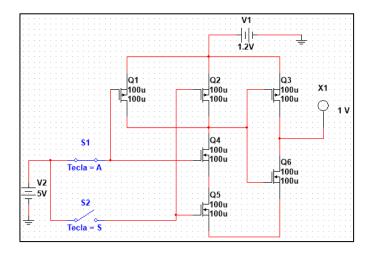


Tabla de verdad			
#	a	b	a.b
1	0	0	0
2	0	1	0
3	1	0	0
4	1	1	1

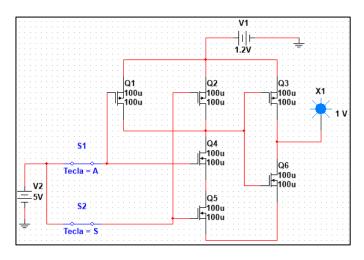
# Comprobación Nº1







# Comprobación Nº4



# Compuerta NOT

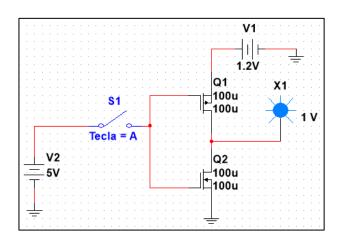
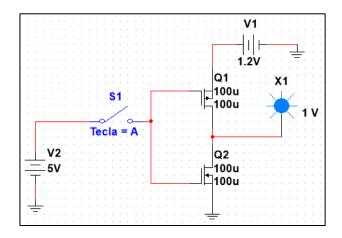
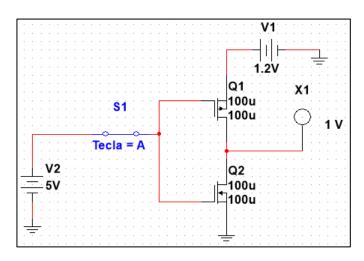


Tabla de verdad			
#	а	ā	
1	0	1	
2	1	0	



# Comprobación Nº2



# Compuerta NOR

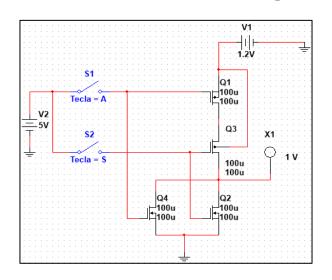
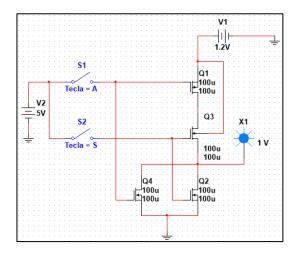
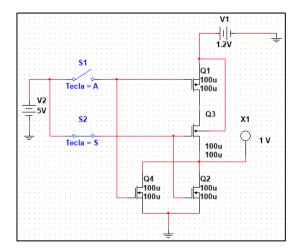
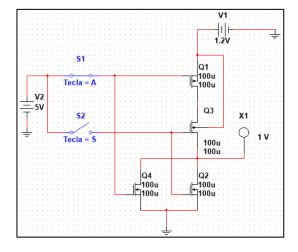


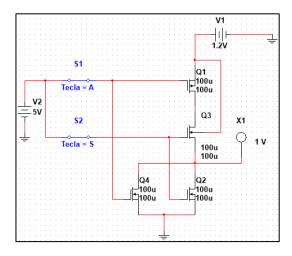
Tabla de verdad				
#	a	b	a+b	$\overline{a+b}$
1	0	0	0	1
2	0	1	1	0
3	1	0	1	0
4	1	1	1	0



# Comprobación Nº2







# Compuerta NAND

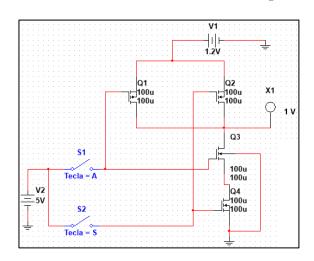
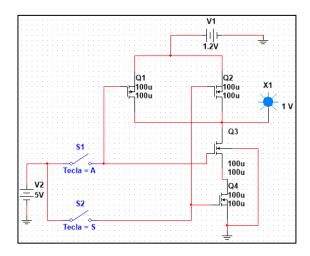
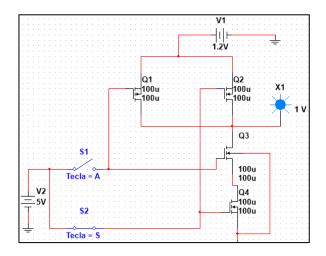
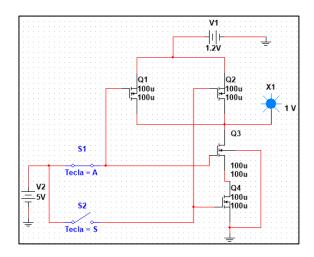


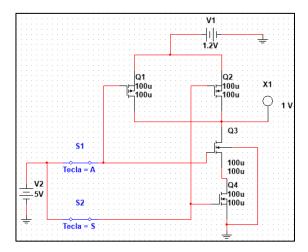
Tabla de verdad				
#	a	b	a.b	a.b
1	0	0	0	1
2	0	1	0	1
3	1	0	0	1
4	1	1	1	0





# Comprobación Nº3:





# Compuerta XOR:

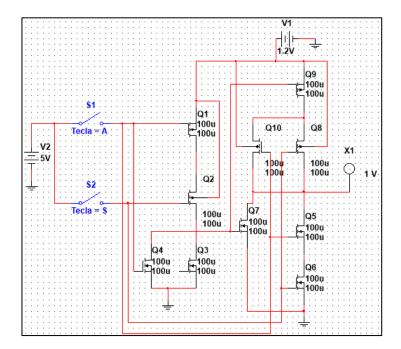
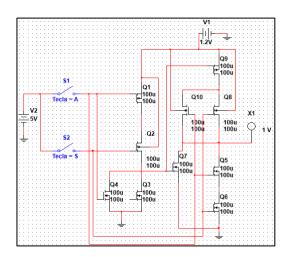
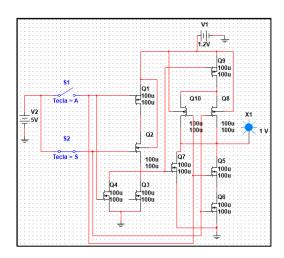
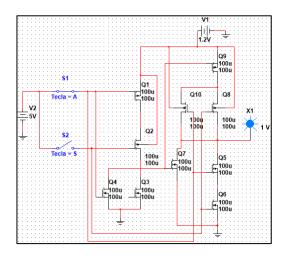


Tabla de verdad			
#	a	b	a⊕b
1	0	0	0
2	0	1	1
3	1	0	1
4	1	1	0

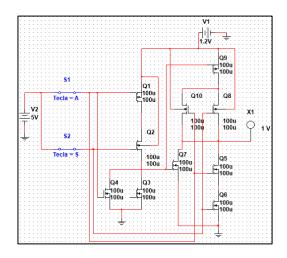
# Comprobación Nº1





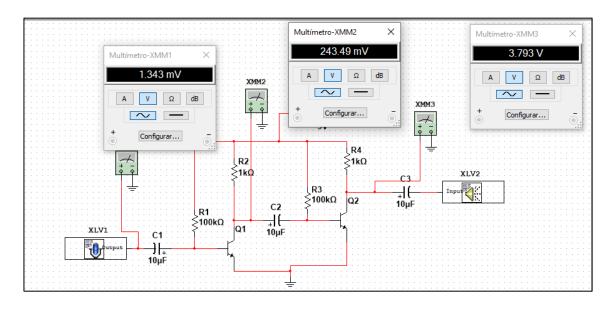


# Comprobación Nº4

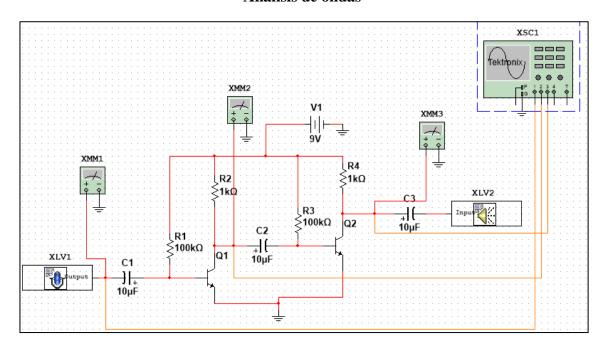


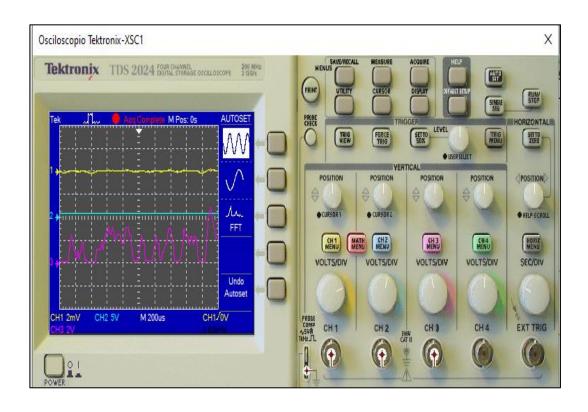
# Amplificador

### Ganancias

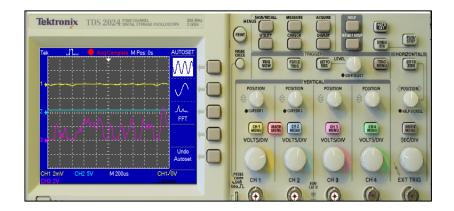


#### Análisis de ondas





**Pre-Amplificador** R3 -^\^\-10kΩ C4 -|(-10μF Q1 2N3370 C2 XT.V2 0.01µF C3 C1 R1 Throutpu 10µF 470pF ≶1МΩ



#### Conclusiones.

- Debemos ser cuidadosos al verificar los terminales del transistor por medio del medidor de continuidad, ya que si erramos alguna parte vamos a obtener datos completamente erróneos del circuito y en la comparación con el simulador no habrá ningún tipo de coincidencia.
- Se debe tomar en cuenta el valor de resistencias y capacitores para la construcción de amplificadores ya que un ligero valor nos podría llevar al transistor a otro estado como el de saturación.
- El mezclador resistivo con un solo FET se caracteriza por una baja distorsión a causa del funcionamiento del mismo, por el bajo ruido y con pérdidas de conversión similares de un mezclador con diodo, gracias a estas cualidades, concluimos que se trata de una estructura apta para el funcionamiento del mezclador.